

5

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平6-244477

(43) 公開日 平成6年 (1994) 9月2日

(51) Int. Cl.⁵

H01L 43/08

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

Z 9274-4M

審査請求 未請求 請求項の数7 (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平3-186807

(22) 出願日 平成3年 (1991) 7月1日

(71) 出願人 000006254

三菱マテリアル株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

(72) 発明者 宮崎 照宣

宮城県仙台市西ノ平2丁目11番5号

(72) 発明者 越村 正己

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三菱マテリアル株式会社セラミックス研究所内

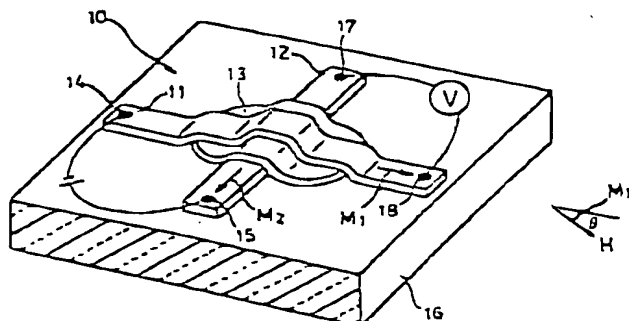
(74) 代理人 弁理士 須田 正彦

(54) 【発明の名称】 磁気抵抗素子

(57) 【要約】

【目的】 室温における抵抗変化率 ($\Delta R/R$) が2%以上であって弱磁場における感度が良好で、安定して使用可能な磁場範囲を有効磁場範囲の2倍以上にする。またその動作点を偏倚させる必要がなく、構造が簡単で小型化し得る。

【構成】 第1強磁性薄膜11と第2強磁性薄膜12とを薄い絶縁層を含む非磁性膜13を挟んで接合し、これにより生じる強磁性トンネル接合を利用した磁気抵抗素子10に関し、強磁性薄膜11、12はそれぞれの磁化容易軸 M_1 、 M_2 が互いに直交するように配置して設けられ、第1強磁性薄膜の磁化容易軸方向の保磁力が第2強磁性薄膜の磁化容易軸方向の保磁力より2倍以上大きいことを特徴とする。第1強磁性薄膜は保磁力が大きなCo元素を主成分とし、第2強磁性薄膜は電子と磁気モーメントとの相互作用が大きなFe、Ni、Co元素のうち少なくとも2種以上含む。



10 磁気抵抗素子 14、15 第1電極
11 第1強磁性薄膜 16 基板
12 第2強磁性薄膜 17、18 第2電極
13 非磁性膜

(2)

特開平6-244477

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1強磁性薄膜(11)と第2強磁性薄膜(12)とを薄い絶縁層を含む非磁性膜(13)を挟んで接合し、これにより生じる強磁性トンネル接合を利用した磁気抵抗素子(10)において、

前記第1及び第2強磁性薄膜(11,12)はそれぞれの磁化容易軸(M_1, M_2)が互いに直交するように配置して設けられ、

前記第1強磁性薄膜(11)の磁化容易軸方向の保磁力が前記第2強磁性薄膜(12)の磁化容易軸方向の保磁力より2倍以上大きいことを特徴とする磁気抵抗素子。

【請求項2】 第1強磁性薄膜(11)がCo元素を20at%以上含む強磁性材料により構成され、第2強磁性薄膜(12)がFe、Ni、Co元素のうち少なくとも2種以上含むCo元素の含有量が40at%以下の強磁性材料により構成された請求項1記載の磁気抵抗素子。

【請求項3】 非磁性膜(13)の全部が絶縁層である請求項1記載の磁気抵抗素子。

【請求項4】 非磁性膜(13)の一部が絶縁層である請求項1記載の磁気抵抗素子。

【請求項5】 非磁性膜(13)がAl層と絶縁層のAl₂O₃層により構成された請求項4記載の磁気抵抗素子。

【請求項6】 絶縁層のAl₂O₃層がAl層の表面を酸化させて形成された請求項5記載の磁気抵抗素子。

【請求項7】 第1及び第2強磁性薄膜(11,12)がそれぞれストライプ状に形成され、かつ両薄膜(11,12)の長手方向が互いに直交するように薄い絶縁層を含む非磁性膜(13)を挟んで両薄膜(11,12)が接合され、

前記第1強磁性薄膜(11)の一端と前記第2強磁性薄膜(12)の一端に両薄膜に一定電流を流すための第1電極(14,15)がそれぞれ設けられ、

前記第1強磁性薄膜(11)の他端と前記第2強磁性薄膜(12)の他端に両薄膜間に印加された電圧を測定するための第2電極(17,18)がそれぞれ設けられた請求項1記載の磁気抵抗素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は磁気エンコーダ、磁気ヘッド、磁気バブル検出器等の感磁部に適した磁気抵抗素子に関する。更に詳しくは強磁性トンネル接合による磁気抵抗効果を利用して磁気信号を検出する磁気抵抗素子に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 図6に示すように、この種の感磁部に用いられる磁気抵抗素子1は、単層の磁気抵抗効果を有する強磁性薄膜を一定幅のストライプ状に加工した後、その長手方向(y方向)の両端に電極2,3を形成して作られる。電極2,3に一定の電流を流し、素子1の幅方向(x方向)に検出すべき磁場を与えたときの電極2,3間の電圧に基づいて算出された抵抗値から磁場が検出

2

される。図7に示すように、従来の磁気抵抗素子は電流の流れる方向に直交する磁場の大きさによって抵抗変化率($\Delta R/R$)が最大2~6%変化する特性を有する。一方、2つの強磁性薄膜を薄い絶縁層を挟んで接合した素子において、強磁性薄膜間に一定のトンネル電流を流し、この状態で強磁性薄膜の膜面に平行に異なる磁場を与えたときの抵抗の変化により、この素子に新しい磁気抵抗効果があることが報告されている(S.Maeckawa and U.Gafvert, IEEE Trans. Magn. MAG-18(1982) 707)。

10 そしてこの報告に基づいて、磁性層に異方性的磁気抵抗効果が小さく、強磁性トンネル効果を分離し易い、Fe系合金を用いた磁気抵抗素子が提案されている(中谷、北田;日本金属学会秋期大会公演摘要, 364(1990))。この磁気抵抗素子は、2層の磁性層の保磁力を異なる値にするために、FeにC及びRuをそれぞれ2at%程度添加し、絶縁層としてAl₂O₃を用いる。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 しかし、前者の強磁性磁気抵抗素子は、図7の磁気抵抗曲線Aに示すように弱20 磁場範囲Bにおける抵抗変化率の変化が小さく感度が良くない不具合があった。また曲線Aがゼロ磁場を中心にしてほぼ左右対称であって、磁場方向に対する極性がないため、従来の磁気抵抗素子はその動作点をゼロ磁場ではなく、図の矢印Cに示す付近に偏倚させて用いられる。この動作点を偏倚させるために従来より磁性膜の近くにバイアス用の磁石を設けているが、この方法ではバイアス用磁石の分だけスペースを要し、構造が複雑化し小型化できないとともにコスト高になる問題点があった。また一般に磁気抵抗素子は実用上2%以上の抵抗変化率を必要とするのに対して、後者の強磁性トンネル接30 合による磁気抵抗効果を利用した磁気抵抗素子は、磁気抵抗効果が十分大きくないため、図8に示すように室温での抵抗変化率が高々1%程度と小さく実用的でなかった。またこの素子は可逆的に特性が変化する磁場範囲Dが狭く、磁気抵抗素子として安定して利用しにくい問題点があった。

【0004】 本発明の目的は、室温における抵抗変化率($\Delta R/R$)が2%以上であって弱磁場における感度が良好で、安定して使用できる範囲を有効磁場範囲の2倍40 以上とすることができる磁気抵抗素子を提供することにある。また本発明の別の目的は、その動作点を偏倚させる必要がなく、構造が簡単で小型化し得る磁気抵抗素子を提供することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】 図1に示すように、本発明は第1強磁性薄膜11と第2強磁性薄膜12とを薄い絶縁層を含む非磁性膜13を挟んで接合し、これにより生じる強磁性トンネル接合を利用した磁気抵抗素子10の改良である。その特徴ある構成は、前記第1及び第250 強磁性薄膜11,12はそれぞれの磁化容易軸 M_1, M_2

3

が互いに直交するように配置して設けられ、第1強磁性薄膜11の磁化容易軸方向の保磁力が第2強磁性薄膜12の磁化容易軸方向の保磁力より2倍以上大きいことにある。

【0006】以下、本発明を詳述する。図1及び図2に示すように、第1強磁性薄膜11と第2強磁性薄膜12とは薄い絶縁層を含む非磁性膜13を挟んで接合される。これら2つの強磁性薄膜11、12はそれぞれの磁化容易軸 M_1 、 M_2 が互いに直交するように配置して設けられ、かつ磁化容易軸方向の保磁力が互いに2倍以上異なることを特徴とする。薄い絶縁層を含む非磁性膜13を挟んで強磁性トンネル接合した強磁性薄膜11及び12に電極14及び15をそれぞれ設け、両電極14、15間に電流を流すと、両電極14、15間に流れるトンネル電流は2つの強磁性薄膜11、12の磁化の向きの相互関係によって異なり、磁化の向きが変わると抵抗値が変化する磁気抵抗効果が現れる。即ち、図2の実線矢印で示すように強磁性薄膜11、12の磁化の向き M_1 、 M_2 が直交するときの抵抗値を R_0 とすると、強磁性薄膜11、12の磁化の向きがそれぞれ同一方向であるとき(M_2 を破線矢印で示す)には抵抗値は $[R_0 - \Delta R / 2]$ となり、強磁性薄膜11、12の磁化の向きが互いに反対方向であるとき(M_2 を一点鎖線矢印で示す)には抵抗値は $[R_0 + \Delta R / 2]$ となる。

【0007】本発明の第一の特徴ある構成は、この強磁性トンネル接合による磁気抵抗効果現象を利用して、2つの強磁性薄膜11、12をそれぞれの磁化容易軸 M_1 、 M_2 が互いに直交するように配置して設けた点にある。これにより、2つの強磁性薄膜11、12の磁化の向きは外部磁場を与えない状態で直交し、両薄膜間の抵抗値は R_0 となる。外部磁場の方向を保磁力の大きな強磁性薄膜11の磁化の向き M_1 にとり、磁場を大きくしていくと、保磁力の小さな強磁性薄膜12の磁化の向き M_2 は徐々に外部磁場の方向に向い、最終的には図の破線矢印に示すように外部磁場方向と一致する。また外部磁場の方向を磁化の向き M_1 と反対にとり、磁場を大きくしていくと、保磁力の小さな強磁性薄膜12の磁化の向き M_2 は同様に図の一点鎖線矢印に示すように外部磁場方向と一致する。しかし、外部磁場の方向が保磁力の大きな強磁性薄膜11の磁化の向き M_1 とは逆でしかもその保磁力より大きいときには、強磁性薄膜11の磁化の向き M_1 が反転し、抵抗値は $[R_0 + \Delta R / 2]$ から $[R_0 - \Delta R / 2]$ になってしまい、極性の検知ができなくなる。このため、本発明の第二の特徴ある構成は、強磁性薄膜11及び12の磁化容易軸方向の保磁力を2倍以上異ならせることにより、可逆的に特性が変化して磁気抵抗素子として安定な磁場範囲Dを有効磁場範囲Eの2倍以上広く確保するようにした点にある。ここで磁気抵抗素子として安定な磁場範囲Dとは、保磁力の小さな強磁性薄膜12の磁化の向きが変わり、かつ保磁力の

(3)

特開平6-244477

4

大きな強磁性薄膜11の磁化の向きの変わらない外部磁場の範囲をいい、有効磁場範囲Eとは磁場により抵抗変化率に変化する範囲をいう。この保磁力の小さい第2強磁性薄膜12は従来の強磁性の磁気抵抗効果を有する材料、即ち電子と磁気モーメントとの相互作用の大きな材料により構成される。例示すればFe、Co、Ni元素のうち少なくとも2種以上含む、同時にCo元素の含有量が40at%以下の強磁性材料が挙げられる。また保磁力が大きい第1強磁性薄膜11はCoを主成分とする材料により構成される。例示すればCo、Co-Sm、Co-Cr-Fe、Co-Pt、Co-Pt-Ni、Co-Pt-V等のCo元素を20at%以上含む強磁性材料が挙げられる。

【0008】強磁性薄膜11及び12に挟まれる層は、数10オングストローム程度の均一な絶縁層を含む非磁性膜13である。絶縁層としては Al_2O_3 層、NiO層等が挙げられる。この層は電子がスピンを保持してトンネルするために非磁性でなければならない。非磁性膜の全部が絶縁層であっても、その一部が絶縁層であってもよい。一部を絶縁層にしてその厚みを極小にすることにより、磁気抵抗効果を更に高めることができる。非磁性膜の一部が絶縁層である例としては、Al膜の一部を酸化させて形成される Al_2O_3 層が挙げられる。

【0009】2つの強磁性薄膜11、12の磁化容易軸 M_1 、 M_2 を互いに直交させるための方法は、図1に示すように強磁性薄膜11、12をイオンビーム蒸着法、真空蒸着法、スパッタリング蒸着法等により形成するとき、エッチングにより、或いは基板にマスクをかぶることにより、ストライプ状にかつこれらの長手方向が互いに直交するように磁場中でそれぞれ形成し、形成時の磁場の方向を薄膜の長手方向にする。この方法で作られた強磁性薄膜11、12は各磁化方向が安定な状態となり、これにより図3の磁気抵抗曲線に示されるヒステリシス現象を小さくすることができる。薄膜11及び12を作る順序としては、図1に示すように、先ずガラス等の基板16上に第2強磁性薄膜12をストライプ状にかつその長手方向が磁化容易軸 M_2 になるように形成し、第2強磁性薄膜12の中央部に薄い絶縁層を含む非磁性膜13を形成し、この非磁性膜13上に第2強磁性薄膜12と長手方向同士が直交するように第1強磁性薄膜11をストライプ状にかつその長手方向が磁化容易軸 M_1 になるように形成する。或いは第1強磁性薄膜11を先に形成し、次いで非磁性膜13を形成し、最後に第2強磁性薄膜12を形成してもよい。

【0010】また、2つの強磁性薄膜11、12間に生じる磁気抵抗効果のみを有効に検出するために、第1強磁性薄膜11の一端と第2強磁性薄膜12の一端に両薄膜に一定電流を流すための第1電極14、15をそれぞれ設け、第1強磁性薄膜11の他端と第2強磁性薄膜12の他端に両薄膜間に印加された電圧を測定するための

(4)

特開平6-244477

第2電極17、18をそれぞれ設けることが好ましい。

【0011】

【作用】第2強磁性薄膜12として、電子と磁気モーメントとの相互作用の大きなFe、Co、Ni元素を2種以上含む合金を強磁性トンネル接合の材料に用いることにより、この薄膜における電子のスピンは上記磁性原子の有する磁気モーメントとの相互作用を反映して揃うと推定される。強磁性トンネル効果は電子がスピンを保持して絶縁層をトンネルすることにより生じる現象であるため、高められた電子のスピンにより強磁性トンネル効果は顕著に現れ、抵抗変化率($\Delta R/R$)は図3に示すように従来の2倍以上の2%を超える実用域まで向上する。また第1強磁性薄膜11として、Coを主成分とする保磁力の大きな材料を用いて、両薄膜11及び12の磁化容易軸方向の保磁力を2倍以上異ならせることにより、図4の磁気抵抗曲線に示すように有効磁場範囲Eの2倍以上の安定な磁場範囲Dが室温において得られる。

【0012】

【発明の効果】以上述べたように、強磁性トンネル接合を利用した従来の磁気抵抗素子の抵抗変化率($\Delta R/R$)が最も高くても1%であったものが、本発明の磁気抵抗素子によれば室温において2%以上の実用域の抵抗変化率が得られ、しかも一方の強磁性薄膜にCoを主成分とする保磁力の大きな材料を用いて、両薄膜の磁化容易軸方向の保磁力を2倍以上異ならせることにより、有効磁場範囲の2倍以上の安定な磁場範囲が室温において得られる。特に、本発明の磁気抵抗素子は弱磁場における抵抗変化率の変化が大きいため、磁場の変化を感度よく検出することができ、従来の磁気抵抗素子と異なり動作点を偏倚させるために磁石を用いてバイアス磁場を与える必要がなく、構造が簡単で小型化し得る利点がある。これにより、磁気エンコーダ、磁気ヘッド、磁気バブル検出器等の磁気を検出する素子として好適に利用することができる。

【0013】

【実施例】次に本発明の実施例を説明する。図1に示すように、ガラス基板16の上に真空蒸着法により厚さが100nmのパーマロイ薄膜(92at%Ni-Fe)12を作製した。これをエッチングにより幅1mm、長さ18mmのストライプ状に形成した。その際磁場を与えて磁化容易軸 M_2 がストライプの長手方向になるようにした。次いでこのパーマロイ薄膜12の中心部に厚さ15nmで直径2.5mmのアルミニウム膜13を真空蒸着により着膜させた。このアルミニウム膜13を空气中に30時間放置して表面を酸化させ、薄い Al_2O_3 からなる絶縁層を形成した。更にこの $Al-Al_2O_3$ 層の上にパーマロイ膜と長手方向同士が直交するように、厚さが100nmで幅1mm、長さ18mmのストライプ状のCo膜11を形成した。このときのCo膜の磁化容

易軸 M_1 はストライプの長手方向となるようにした。Co膜11とパーマロイ薄膜12の各一端に電極14及び15を設け、それぞれ他端に電極17及び18を設けて磁気抵抗素子10を得た。

【0014】温度25℃において、基板16の表面に平行にかつ磁化容易軸 M_1 に対して角度 θ だけ偏向して磁場Hを磁気抵抗素子10に与え、電極14及び15に一定電流を流し、電極17及び18によりCo膜11とパーマロイ薄膜12間の電圧を測定した。この電流値と電圧値より素子10の抵抗を算出した。図4の磁気抵抗曲線に示すように、磁場Hの強さを変えたときの抵抗変化率($\Delta R/R$)は最大で2.7%の極めて高い値であった。図4の範囲Eが磁場により $\Delta R/R$ が変化する有効磁場範囲であり、範囲Dが保磁力の大きなCo膜がその磁化の向きを変えない磁気抵抗素子として安定な磁場範囲である。範囲Dを超えた磁場が磁気抵抗素子に与えられると、Co膜の磁化は磁場方向に向くようになり、 $\Delta R/R$ の値は小さくなる。この挙動は図5の磁化曲線に示される。図4及び図5から本実施例の磁気抵抗素子10は安定な磁場範囲Dが有効磁場範囲Eの2~3倍あることが判る。

【0015】図3に示すように、この安定な磁場範囲Dで $\Delta R/R$ を測定してみたところ、この磁気抵抗曲線がらこの素子10は弱磁場での感度が高く、しかも曲線はゼロ磁場に関して非対称であるため、特別にバイアス磁場を与えなくても磁場Hの方向を検出することができた。なお、図3の磁気抵抗曲線では若干のヒステリシス現象がみられたが、実用上この程度のヒステリシスは問題なく、磁性薄膜を形成するときの2つの磁化容易軸が完全に直交すればこの現象はなくなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明実施例の磁気抵抗素子の斜視図。

【図2】本発明の強磁性トンネル接合を利用した磁気抵抗素子の原理を示す斜視図。

【図3】その可逆領域Dにおける磁気抵抗曲線図。

【図4】その磁気抵抗曲線図。

【図5】その磁化曲線図。

【図6】従来例の強磁性磁気抵抗効果を利用した磁気抵抗素子の斜視図。

【図7】その磁気抵抗曲線。

【図8】従来例の強磁性トンネル接合を利用した磁気抵抗素子の磁気抵抗曲線。

【符号の説明】

10 磁気抵抗素子

11 第1強磁性薄膜

12 第2強磁性薄膜

13 非磁性膜

14、15 第1電極

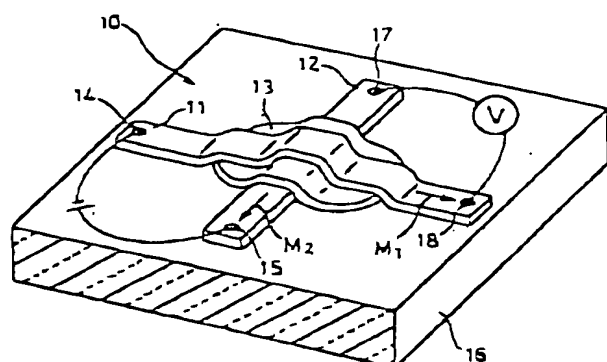
16 基板

17、18 第2電極

(5)

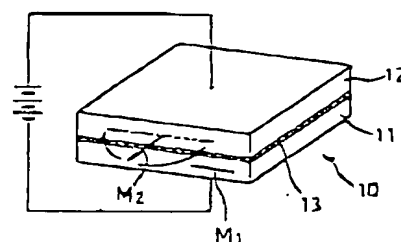
特開平6-244477

【図1】

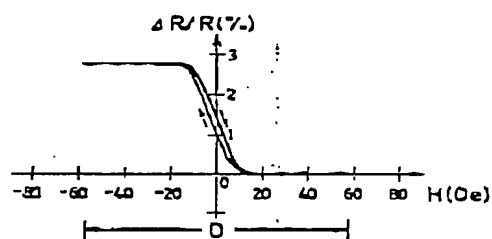


- 10 電気伝導層 14, 15 第1電極
 11 第1磁性層 16 基底
 12 第2磁性層 17, 18 第2電極
 13 非磁性層

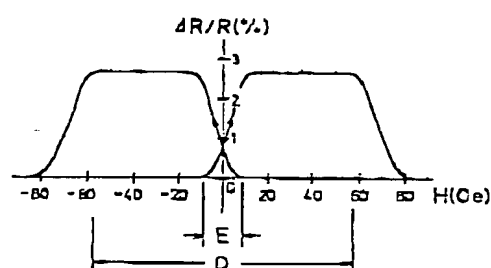
【図2】



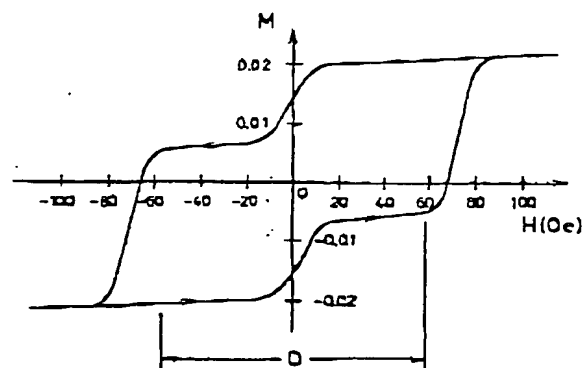
【図3】



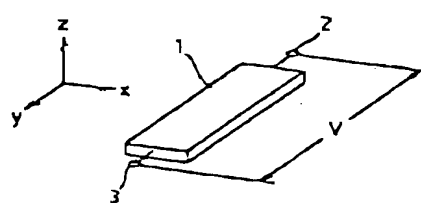
【図4】



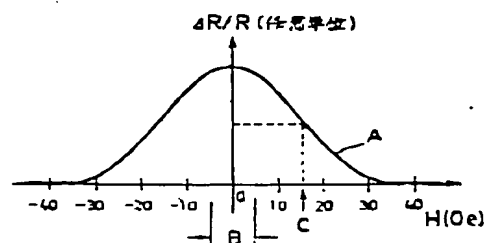
【図5】



【図6】



【図7】



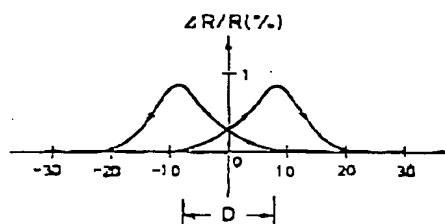
(6)

特開平6-244477

9

10

【図8】



【手続補正書】

【提出日】平成3年9月2日

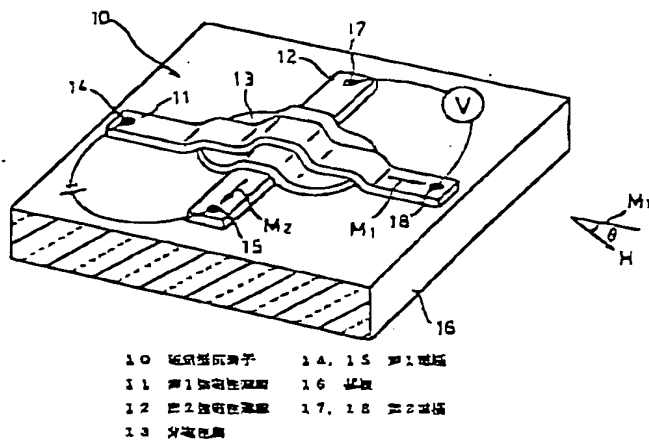
【手続補正1】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図1

【補正方法】変更

【補正内容】



【手続補正書】

【提出日】平成6年4月21日

【手続補正1】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図1

【補正方法】変更

【補正内容】

【図1】

